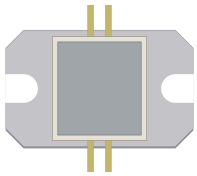
200–2200 MHz 金属陶瓷封装GaN MMIC功率放大器

LCI-PA-200-2200-PS41T — 200–2200 MHz 金属陶瓷封装GaN MMIC功率放大器.

饱和输出功率: 39.5 dBm (最小值) / 41 dBm (典型值); 功率增益: 23.5 dB (最小值) / 25 dB (典型值); 功率附加效率: 40 % (最小值) / 50 % (典型值).



RF 特性

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = +16 dBm

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	-	200	-	2200	MHz
饱和输出功率	-	39.5	41	-	dBm
功率增益	-	23.5	25	-	dB
功率增益平坦度	-	-	-	±1	dB
功率附加效率	-	40	50	-	%
小信号增益	-	-	30	-	dB
小信号增益平坦度	-	-	-	±2	dB
输入驻波比	-	-	1.5	2	-

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	-2.6	V

电气特性

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值
封装	-	-	-	-	QF92-4AC
供电引脚	-	-	-	-	1 (Vg)
RF输入引脚	-	-	-	-	2
供电引脚	-	-	-	-	3 (Vd)
RF输出引脚	-	-	-	-	4

极限参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
最大输入功率	-	-	-	20	dBm

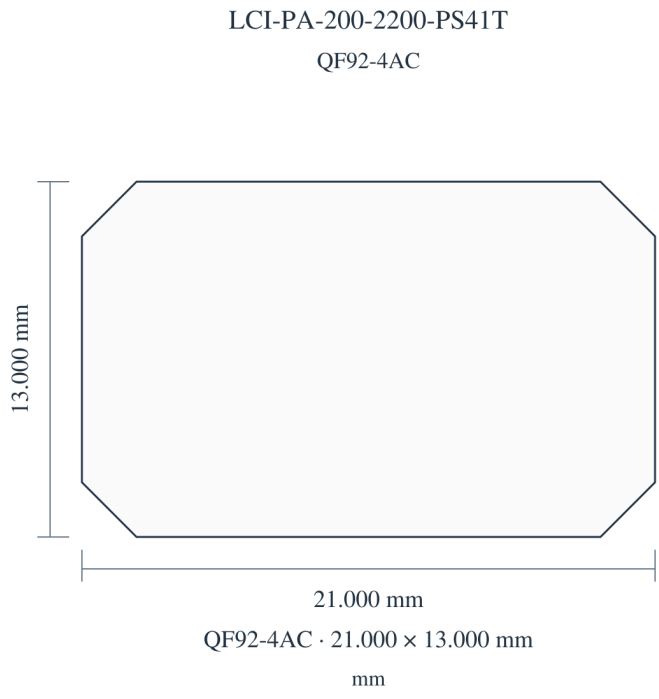
环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片平面尺寸	21 × 13	mm

仅显示安装法兰的平面尺寸，单位 mm；不代表包含引脚的完整封装包络。



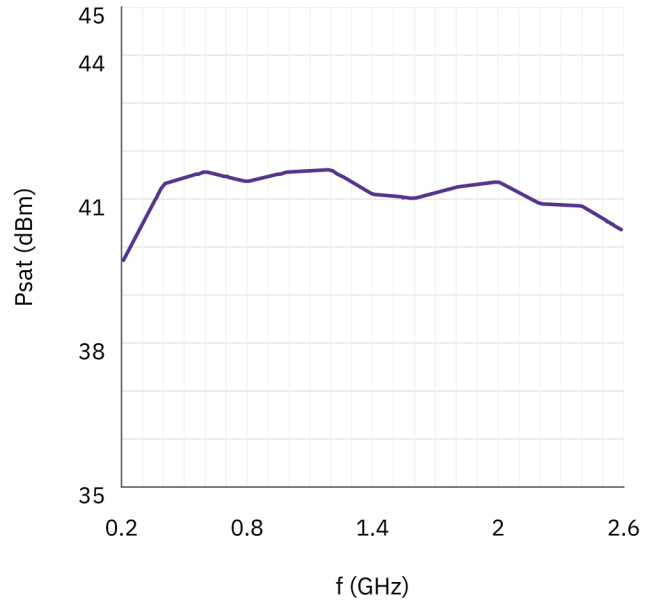
当前出版记录 · 1.5 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.4.

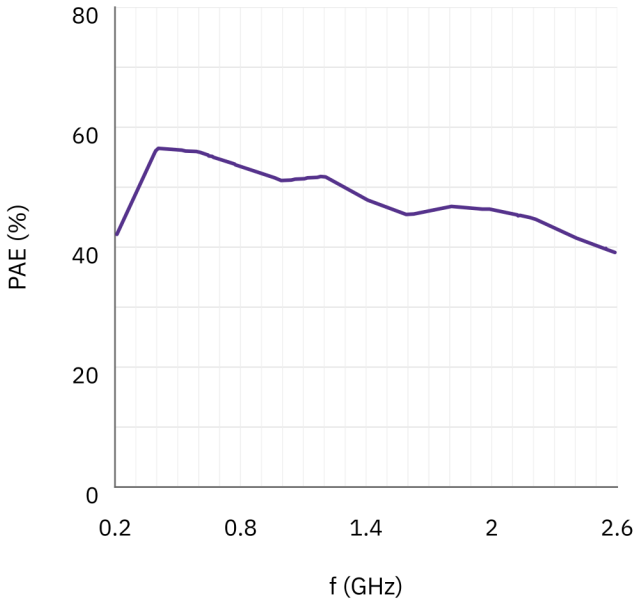
性能曲线

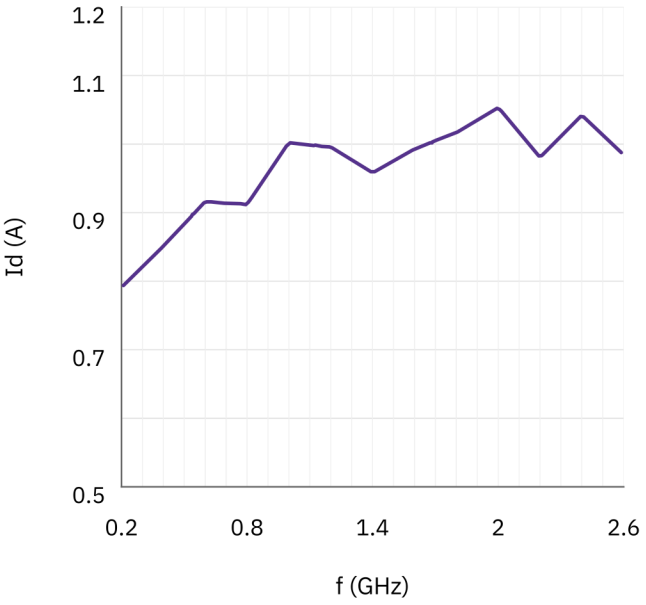
请结合每张图标明的工作条件阅读。

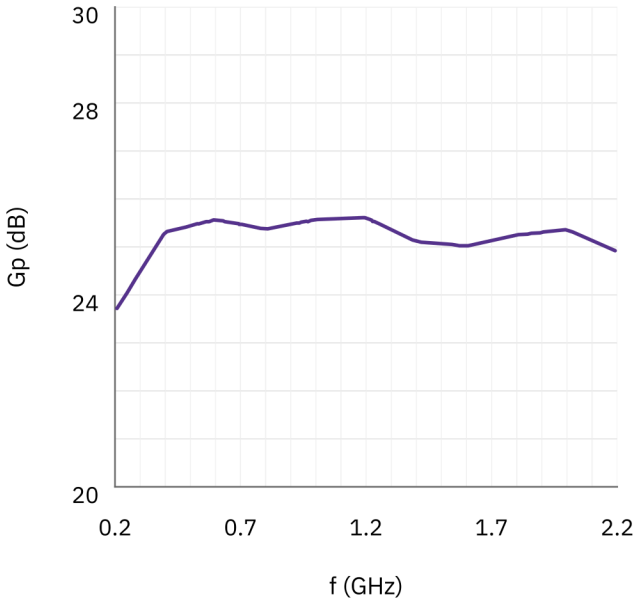
连续波（CW） — 饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益。

图注： TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.4V; Pin=16dBm。 图中读数为近似值。









文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。